

名称: 无锡中微腾芯电子有限公司

地址: 江苏省滨湖区惠河路 5 号

| 序号 | 产品/产品类别        | 项目/参数 |                    | 检测标准(方法)名称及编号(含年号)                           | 限制范围  | 测量容量 | 备注 |
|----|----------------|-------|--------------------|--|---|------|----|
|    |                | 序号    | 名称                 |  |   |      |    |
| 1  | IC (MOS 随机存储器) | 1     | 全“0”全“1”功能测试       | 半导体集成电路<br>第 2 部分: 数字集成电路<br>GB/T 17574-1998 | 只测电压-1V~6V<br>电流: -200mA~200mA<br>最大 512 通道 |      |    |
|    |                | 2     | 校验板功能测试            | 半导体集成电路<br>第 2 部分: 数字集成电路<br>GB/T 17574-1998 | 只测电压-1V~6V<br>电流: -200mA~200mA<br>最大 512 通道 |      |    |
|    |                | 3     | 输出高电平电压 $V_{OH}$   | 半导体集成电路<br>第 2 部分: 数字集成电路<br>GB/T 17574-1998 | 只测电压-1V~6V<br>电流: -200mA~200mA<br>最大 512 通道 |      |    |
|    |                | 4     | 输出低电平电压 $V_{OL}$   | 半导体集成电路<br>第 2 部分: 数字集成电路<br>GB/T 17574-1998 | 只测电压-1V~6V<br>电流: -200mA~200mA<br>最大 512 通道 |      |    |
|    |                | 5     | 输入负载电流 $I_{LI}$    | 半导体集成电路<br>第 2 部分: 数字集成电路<br>GB/T 17574-1998 | 只测电压-1V~6V<br>电流: -200mA~200mA<br>最大 512 通道 |      |    |
|    |                | 6     | 工作状态电源电流 $I_{CC}$  | 半导体集成电路<br>第 2 部分: 数字集成电路<br>GB/T 17574-1998 | 只测电压-1V~6V<br>电流: -200mA~200mA<br>最大 512 通道 |      |    |
|    |                | 7     | 维持状态电源电流 $I_{CCS}$ | 半导体集成电路<br>第 2 部分: 数字集成电路<br>GB/T 17574-1998 | 只测电压-1V~6V<br>电流: -200mA~200mA<br>最大 512 通道 |      |    |

|   |                |   |                   |  |   |  |  |
|---|----------------|---|-------------------|--|---|--|--|
| 2 | IC (电压调整器)     | 1 | 输出电压 $V_o$        | 半导体集成电路电压调整测试方法<br>GB/T 4377-2018            | 只测电压-40V~40V<br>电流: -1A~1A<br>最大 48 通道      |  |  |
|   |                | 2 | 电压调整率 $S_v$       | 半导体集成电路电压调整测试方法<br>GB/T 4377-2018            | 只测电压-40V~40V<br>电流: -1A~1A<br>最大 48 通道      |  |  |
|   |                | 3 | 电流调整率 $S_i$       | 半导体集成电路电压调整测试方法<br>GB/T 4377-2018            | 只测电压-40V~40V<br>电流: -1A~1A<br>最大 48 通道      |  |  |
| 3 | IC (模拟开关)      | 1 | 模拟开关工作范围<br>$V_A$ | 半导体集成电路模拟开关测试方法<br>GB/T 14028-2018           | 只测电压-40V~40V<br>电流: -1A~1A<br>最大 48 通道      |  |  |
| 4 | IC (DC-DC 变换器) | 1 | 输出电压 $V_o$        | 混合集成电路 DC/DC 变换器测试方法<br>SJ 20646-1997        | 只测电压-40V~40V<br>电流: -1A~1A<br>最大 48 通道      |  |  |
|   |                | 2 | 输出电流 $I_o$        | 混合集成电路 DC/DC 变换器测试方法<br>SJ 20646-1997        | 只测电压-40V~40V<br>电流: -1A~1A<br>最大 48 通道      |  |  |
|   |                | 3 | 电压调整率 $S_v$       | 混合集成电路 DC/DC 变换器测试方法<br>SJ 20646-1997        | 只测电压-40V~40V<br>电流: -1A~1A<br>最大 48 通道      |  |  |
|   |                | 4 | 电流调整率 $S_i$       | 混合集成电路 DC/DC 变换器测试方法<br>SJ 20646-1997        | 只测电压-40V~40V<br>电流: -1A~1A<br>最大 48 通道      |  |  |
| 5 | IC (微处理器)      | 1 | 输入高电平电流 $I_{IH}$  | 半导体集成电路<br>第 2 部分: 数字集成电路<br>GB/T 17574-1998 | 只测电压-1V~6V<br>电流: -200mA~200mA<br>最大 512 通道 |  |  |

|   |                               |   |                  |   |  |                                     |  |
|---|-------------------------------|---|------------------|---|--|-------------------------------------|--|
|   |                               | 2 | 输入低电平电流 $I_{IL}$ | 半导体集成电路<br>第 2 部分：数字集成电路<br>GB/T 17574-1998 | 只测电压-1V~6V<br>电流：-200mA~200mA<br>最大 512 通道         |                                     |  |
|   |                               | 3 | 静态工作电流 $I_{SB}$  | 半导体集成电路<br>第 2 部分：数字集成电路<br>GB/T 17574-1998 | 只测电压-1V~6V<br>电流：-200mA~200mA<br>最大 512 通道         |                                     |  |
|   |                               | 4 | 动态工作电流 $I_A$     | 半导体集成电路<br>第 2 部分：数字集成电路<br>GB/T 17574-1998 | 只测电压-1V~6V<br>电流：-200mA~200mA<br>最大 512 通道         |                                     |  |
|   |                               | 5 | 功能测试 test        | 半导体集成电路<br>第 2 部分：数字集成电路<br>GB/T 17574-1998 | 只测电压-1V~6V<br>电流：-200mA~200mA<br>最大 512 通道         |                                     |  |
|   |                               | 6 | 输出高电平电压 $V_{OH}$ | 半导体集成电路<br>第 2 部分：数字集成电路<br>GB/T 17574-1998 | 只测电压-1V~6V<br>电流：-200mA~200mA<br>最大 512 通道         |                                     |  |
|   |                               | 7 | 输出低电平电压 $V_{OL}$ | 半导体集成电路<br>第 2 部分：数字集成电路<br>GB/T 17574-1998 | 只测电压-1V~6V<br>电流：-200mA~200mA<br>最大 512 通道         |                                     |  |
|   |                               | 8 | 输入高电平电压 $V_{IH}$ | 半导体集成电路<br>第 2 部分：数字集成电路<br>GB/T 17574-1998 | 只测电压-1V~6V<br>电流：-200mA~200mA<br>最大 512 通道         |                                     |  |
|   |                               | 9 | 输入低电平电压 $V_{IL}$ | 半导体集成电路<br>第 2 部分：数字集成电路<br>GB/T 17574-1998 | 只测电压-1V~6V<br>电流：-200mA~200mA<br>最大 512 通道         |                                     |  |
| 6 | 电阻（固定电阻器、金属膜电阻器、薄膜电阻器、线绕电阻器、电 | 1 | 标称阻值             | 电子设备用固定电阻器<br>第 1 部分：总规范<br>GB/T 5729-2003  | 只测：<br>阻值范围：0.00001 $\Omega$<br>~99.9999M $\Omega$ | 0.00001 $\Omega$ ~99.9999M $\Omega$ |  |

|   |  |   |            |  |  |                                |  |
|---|--|---|------------|--|--|--------------------------------|--|
|   |  | 2 | 终端电阻       | 电子设备用电位器<br>第1部分：总规范<br>GB/T 15298-1994          | 只测：<br>阻值范围：0.00001 Ω<br>~99.9999M Ω           | 0.00001 Ω~99.9999M Ω           |  |
| 7 | 二极管（稳压二极管、开关二极管、整流二极管、肖特基二极管、瞬态抑制二极管、发光二极管、硅功率开关二极管） | 1 | 正向电压       | 半导体器件分立器件和集成电路<br>第2部分：整流二极管<br>GB/T 4023-2015   | 只用脉冲法<br>只测：电压范围：<br>0V~2000V，<br>电流范围：0A~200A | 电压范围：0V~2000V，<br>电流范围：0A~200A |  |
|   |  | 2 | 反向电流       | 半导体器件分立器件和集成电路<br>第2部分：整流二极管<br>GB/T 4023-2015   | 只用直流法<br>只测：电压范围：<br>0V~2000V，<br>电流范围：0A~200A | 电压范围：0V~2000V，<br>电流范围：0A~200A |  |
|   |  | 3 | 击穿电压       | 半导体器件分立器件和集成电路<br>第2部分：整流二极管<br>GB/T 4023-2015   | 只测：电压范围：<br>0V~2000V，<br>电流范围：0A~200A          | 电压范围：0V~2000V，<br>电流范围：0A~200A |  |
|   |  | 4 | 工作电压       | 半导体分立器件<br>第3部分：信号（包括开关）和调整二极管<br>GB/T 6571-1995 | 只测：电压范围：<br>0V~2000V，<br>电流范围：0A~200A          | 电压范围：0V~2000V，<br>电流范围：0A~200A |  |
|   |  | 5 | 微分电阻       | 半导体分立器件<br>第3部分：信号（包括开关）和调整二极管<br>GB/T 6571-1995 | 只测：电压范围：<br>0V~2000V，<br>电流范围：0A~200A          | 电压范围：0V~2000V，<br>电流范围：0A~200A |  |
| 8 | 三极管（开关三极管、功率三极管）                                     | 1 | 集电极-基极击穿电压 | 半导体分立器件和集成电路<br>第七部分：双极型晶体管<br>GB/T 4587-1994    | 只测：电压范围：<br>0V~2000V，<br>电流范围：0A~200A          | 电压范围：0V~2000V，<br>电流范围：0A~200A |  |
|   |  | 2 | 发射极-基极击穿电压 | 半导体分立器件和集成电路<br>第七部分：双极型晶体管<br>GB/T 4587-1994    | 只测：电压范围：<br>0V~2000V，<br>电流范围：0A~200A          | 电压范围：0V~2000V，<br>电流范围：0A~200A |  |
|   |  | 3 | 集电极-基极截止电流 | 半导体分立器件和集成电路<br>第七部分：双极型晶体管<br>GB/T 4587-1994    | 只测：电压范围：<br>0V~2000V，<br>电流范围：0A~200A          | 电压范围：0V~2000V，<br>电流范围：0A~200A |  |

|   |                       |   |             |   |                                       |                                |  |
|---|-----------------------|---|-------------|---|---------------------------------------|--------------------------------|--|
|   |                       | 4 | 集电极-发射极饱和电压 | 半导体分立器件和集成电路<br>第七部分：双极型晶体管<br>GB/T 4587-1994                           | 只测：电压范围：<br>0V~2000V，<br>电流范围：0A~200A | 电压范围：0V~2000V，<br>电流范围：0A~200A |  |
|   |                       | 5 | 发射极-基极截止电流  | 半导体分立器件和集成电路<br>第七部分：双极型晶体管<br>GB/T 4587-1994                           | 只测：电压范围：<br>0V~2000V，<br>电流范围：0A~200A | 电压范围：0V~2000V，<br>电流范围：0A~200A |  |
|   |                       | 6 | 集电极-发射极截止电流 | 半导体分立器件和集成电路<br>第七部分：双极型晶体管<br>GB/T 4587-1994                           | 只测：电压范围：<br>0V~2000V，<br>电流范围：0A~200A | 电压范围：0V~2000V，<br>电流范围：0A~200A |  |
|   |                       | 7 | 共发射极正向电流传输比 | 半导体分立器件和集成电路<br>第七部分：双极型晶体管<br>GB/T4587-1994                            | 只测：电压范围：<br>0V~2000V，<br>电流范围：0A~200A | 电压范围：0V~2000V，<br>电流范围：0A~200A |  |
| 9 | 场效应管（结型场效应管、绝缘栅型场效应管） | 1 | 漏源击穿电压      | 半导体分立器件试验方法<br>第3部分 试验方法 3000 到 3999<br>MIL-STD-750-3-2019<br>方法 3407.1 | 只测：电压范围：<br>0V~2000V，<br>电流范围：0A~200A | 电压范围：0V~2000V，<br>电流范围：0A~200A |  |
|   |                       | 2 | 阈值电压        | 半导体器件 分立器件<br>第8部分：场效应晶体管<br>GB/T 4586-1994<br>第IV章第6条                  | 只测：电压范围：<br>0V~2000V，<br>电流范围：0A~200A | 电压范围：0V~2000V，<br>电流范围：0A~200A |  |
|   |                       | 3 | 栅极截止电流      | 半导体器件 分立器件<br>第8部分：场效应晶体管<br>GB/T 4586-1994<br>第IV章第2条                  | 只测：电压范围：<br>0V~2000V，<br>电流范围：0A~200A | 电压范围：0V~2000V，<br>电流范围：0A~200A |  |
|   |                       | 4 | 漏极电流        | 半导体器件 分立器件<br>第8部分：场效应晶体管<br>GB/T 4586-1994<br>第IV章第3条                  | 只测：电压范围：<br>0V~2000V，<br>电流范围：0A~200A | 电压范围：0V~2000V，<br>电流范围：0A~200A |  |
|   |                       | 5 | 通态漏源电阻      | 半导体器件 分立器件<br>第8部分：场效应晶体管<br>GB/T 4586-1994<br>第IV章第16条                 | 只测：电压范围：<br>0V~2000V，<br>电流范围：0A~200A | 电压范围：0V~2000V，<br>电流范围：0A~200A |  |

|    |                    |                                      |               |  |  |   |  |
|----|--------------------|--------------------------------------|---------------|--|--|---|--|
| 10 | AECQ-100<br>集成电路试验 | 1                                    | 预处理           | 非密封表面贴装器件的湿度/回流焊敏感度分级<br>JEDEC J-STD-020F-2022     | 仅针对塑封器件  | 温度: 25°C-150°C;<br>湿度: 30%RH-98%RH<br>回流焊温度: 25°C<br>-300°C |  |
|    |                    |                                      |               | 非密封表贴器件可靠性试验前<br>预处理<br>JEDEC JESD22-A113I-2020    |  |   |  |
|    |                    | 2                                    | 带偏置稳态湿热       | 带偏置稳态湿热寿命试验<br>JEDEC JESD22-A101D.01-2021          | 只测: 条件范围<br>温度: 25°C-150°C;<br>湿度: 30%RH-98%RH | 温度: 25°C-150°C;<br>湿度: 30%RH-98%RH                          |  |
|    |                    | 3                                    | 带偏置高加速温湿度应力试验 | 高加速湿热应力试验<br>JEDEC JESD22-A110E.01-2021            | 只测: 条件范围<br>温度: 105-150°C;<br>湿度: 65%-100%RH   | 温度: 105°C-150°C;<br>湿度: 65%-100%RH                          |  |
|    |                    | 4                                    | 高压蒸煮          | 加速湿度抵抗-无偏置高压蒸煮<br>JEDEC JESD22-A102E-2015          | 只测: 条件范围<br>温度: 100-134°C;<br>湿度: 100%RH       | 温度: 100°C-134°C,<br>湿度: 100%RH                              |  |
|    |                    | 5                                    | 无偏置高加速温湿度应力试验 | 加速湿度抵抗-无偏置高加速温湿度应力试验<br>JEDEC JESD22-A118B.01-2021 | 只测: 条件范围<br>温度: 105°C-150°C;<br>湿度: 65%-100%RH | 温度: 105°C-150°C;<br>湿度: 65%-100%RH                          |  |
|    |                    | 6                                    | 无偏置高加速温湿度应力试验 | 带偏置稳态湿热寿命试验<br>JEDEC JESD22-A101D.01-2021          | 只测: 条件范围<br>温度: 25°C-150°C;<br>湿度: 30%RH-98%RH | 温度: 25°C-150°C;<br>湿度: 30%RH-98%RH                          |  |
|    |                    | 7                                    | 温度循环          | 温度循环<br>JEDEC JESD22-A104F.01-2023                 | 只测: 条件范围<br>温度范围: -65°C<br>-150°C              | 温度范围: -65-150°C   |  |
| 8  | 高温贮存寿命             | 高温存储寿命<br>JEDEC JESD22-A103E.01-2021 | 只做条件 A、B、C、D  | 温度范围: 25°C-150°C                                   |  |   |  |

|  |  |    |                       |  |                        |               |  |
|--|--|----|-----------------------|--|------------------------|---------------|--|
|  |  | 9  | 高温工作寿命                | 温度、偏置和工作寿命<br>JEDEC JESD22-A108G-2022              | 只测温度范围：25℃<br>-150℃    | 温度范围：25℃-150℃ |  |
|  |  | 10 | 早期寿命失效率               | 早期寿命失效率<br>AEC-Q100-008A-2003                      | 只测温度范围：25℃<br>-150℃    | 温度范围：25℃-150℃ |  |
|  |  | 11 | 非易失性<br>存储器数据<br>擦写保持 | 非易失存储器程序/擦除耐久性，数据保持和可操作寿命试验<br>AEC-Q100-005D1-2012 | 只测温度范围：25℃<br>-150℃    | 温度范围：25℃-150℃ |  |
|  |  | 12 | 邦线剪切                  | 引线邦定剪切试验<br>AEC-Q100-001C-1998                     | 全尺寸                    | 剪切力≤100kg     |  |
|  |  | 13 | 邦线拉力                  | 微电子器件试验方法<br>MIL-STD-883L-2019<br>方法 2011.10       | 只做条件 C、D<br>只测：拉力≤100g | 拉力≤100g       |  |
|  |  | 14 | 可焊性                   | 元器件引脚，焊端，焊片，端子和导线可焊性试验<br>J-STD-002E-2017          | 仅限浸焊和回流焊               | 温度范围 25℃-350℃ |  |
|  |  | 15 | 物理尺寸                  | 物理尺寸测量<br>JEDEC JESD22-B100B-2003                  | 尺寸≤400mm               | 精度：0.0001mm   |  |
|  |  | 16 | 锡球剪切                  | 锡球剪切试验<br>AEC-Q100-010A-2003                       | 全尺寸                    | 剪切力≤100kg     |  |
|  |  | 17 | 引脚完整性                 | 引脚完整性<br>JESD22-B105E-2017                         | 只做条件 A、B               | 拉力≤4Kg        |  |

|    |                    |   |             |   |                 |   |  |
|----|--------------------|---|-------------|---|-----------------|---|--|
|    |                    | 18  | 机械冲击        | 机械振动-器件和组件<br>JEDEC JESD22-B110B.01-2019        | 只做条件 A、B、F      | 加速度 $\leq$ 5000g  |  |
|    |                    | 19  | 变频振动        | 变频振动<br>JEDEC JESD22-B103B.01-2016              | 只做扫频振动条件 1      | 频率范围: 5HZ~2000HZ<br>加速度 $\leq$ 50g  |  |
|    |                    | 20  | 恒定加速度<br>试验 | 微电子器件试验方法<br>MIL-STD-883L-2019<br>方法 2001.4     | 只做条件 A-E        | 加速度 $\leq$ 50000g   |  |
|    |                    | 21  | 密封试验        | 微电子器件试验方法<br>MIL-STD-883L-2019<br>方法 1014.17    | 仅做试验条件 A、C      | 细检漏: 示踪气体氦<br>(He)<br>粗检漏: 碳氟化合物  |  |
|    |                    | 22  | 芯片剪切        | 微电子器件试验方法<br>MIL-STD-883L-2019<br>方法 2019.10    | 全尺寸             | 剪切力 $\leq$ 100kg  |  |
| 11 | AECQ-101<br>分立器件试验 | 1   | 预处理         | 非密封表贴器件可靠性试验前<br>预处理<br>JEDEC JESD22-A113I-2020 | 仅针对塑封器件         | 温度: 25 $^{\circ}$ C-150 $^{\circ}$ C;<br>湿度: 30%RH-98%RH<br>回流焊温度: 25 $^{\circ}$ C<br>-300 $^{\circ}$ C |  |
|    |                    |   |             | 非密封表面贴装器件的湿度/回流焊敏感度分级<br>JEDEC J-STD-020F-2022  |                 |   |  |
|    |                    | 2   | 目检          | 外观目检<br>JEDEC JESD22-B101D-2022                 | 放大倍数: 7.5~100 倍 | 放大倍数: 7.5~100 倍   |  |
| 3  | 高温反偏试验             | 半导体分立器件试验方法 第 2 部分<br>MIL-STD-750-1A-2016<br>方法 1038.5、1039.4 | 针对条件 A      | 电压 $\leq$ 1500V<br>温度: 25~175 $^{\circ}$ C      |                 |   |  |



|  |  |    |            |  |   |  |  |
|--|--|----|------------|--|---|--|--|
|  |  | 4  | 高温栅偏试验     | 温度、偏置和工作寿命<br>JEDEC JESD22-A108G-2022                | 只测：条件范围<br>电压≤1500V<br>温度：25~175℃         | 电压≤1500V<br>温度：25~175℃                               |  |
|  |  | 5  | 温度循环       | 温度循环<br>JEDEC JESD22-A104F.01-2023                   | 只测：条件范围<br>温度范围：-65℃<br>-150℃             | 温度范围：-65℃-150℃                                       |  |
|  |  | 6  | 无偏置高加速压力试验 | 加速湿度抵抗-无偏置高加速温湿度应力试验<br>JEDEC JESD22-A118B.01-2021   | 只测：条件范围<br>温度：105-150℃；<br>湿度：65%-100%RH  | 温度：105℃-150℃；<br>湿度：65%-100%RH                       |  |
|  |  | 7  | 高加速应力试验    | 带偏置高加速温湿度应力试验<br>JEDEC JESD22-A110E.01-2021          | 只测：条件范围<br>温度：105-150℃；<br>湿度：65%-100%RH  | 温度：105℃-150℃；<br>湿度：65%-100%RH                       |  |
|  |  | 8  | 高温高湿反向偏压   | 带偏置稳态湿热寿命试验<br>JEDEC JESD22-A101D.01-2021            | 只测：条件范围<br>温度：25℃-150℃；<br>湿度：30%RH-98%RH | 温度：25℃-150℃；<br>湿度：30%RH-98%RH                       |  |
|  |  | 9  | 间歇寿命试验     | 半导体分立器件试验方法 第1部分<br>MIL-STD-750-1A-2016<br>方法 1037.3 | 仅针对无散热条件                                  | 功率≤10W   |  |
|  |  | 10 | 物理尺寸       | 物理尺寸测量<br>JEDEC JESD22-B100B-2003                    | 尺寸≤400mm                                  | 精度：0.0001mm  |  |
|  |  | 11 | 引出端强度      | 半导体分立器件试验方法 第2部分<br>MIL-STD-750-2A-2018<br>方法 2036.5 | 只做条件 A、E                                  | 拉力≤4Kg   |  |
|  |  | 12 | 耐溶剂性       | 印记持久性<br>JEDEC JESD22-B107D-2011                     | 只做油墨打标                                    | 混合溶剂 1：纯异丙醇<br>75号航空汽油<br>混合溶剂 2：松节油<br>混合溶剂 3：去离子水、 |  |

|  |  |    |       |  |            |                                    |  |
|--|--|----|-------|--|------------|------------------------------------|--|
|  |  | 13 | 恒定加速度 | 半导体分立器件试验方法 第 2 部分<br>MIL-STD-750-2A-2018<br>方法 2006.2 | 只做条件 A-E   | 加速度 $\leq$ 50000g                  |  |
|  |  | 14 | 变频振动  | 变频振动<br>JEDEC JESD22-B103B.01-2016                     | 只做扫频振动条件 1 | 频率范围: 5HZ~2000HZ<br>加速度 $\leq$ 50g |  |
|  |  | 15 | 机械冲击  | 机械振动-器件和组件<br>JEDEC JESD22-B110B.01-2019               | 只做条件 A、B、F | 加速度 $\leq$ 50000g                  |  |
|  |  | 16 | 密封试验  | 密封<br>JEDEC JESD22-A109B-2011                          | 仅做试验条件 A、C | 细检漏: 示踪气体氦 (He)<br>粗检漏: 碳氟化合物      |  |
|  |  | 17 | 耐焊接热  | 安装在单面板底面的小型表贴固态器件耐浸焊能力的评估流程<br>JEDEC JESD22-A111B-2018 | 仅做浸焊及回流焊   | 最高温度 $\leq$ 350℃                   |  |
|  |  |    |       | 通孔安装器件的耐焊接冲击<br>JEDEC JESD22-B106E-2016                | 仅做浸焊及回流焊   | 最高温度 $\leq$ 350℃                   |  |
|  |  | 18 | 可焊性   | 元器件引脚, 焊端, 焊片, 端子和导线可焊性试验<br>J-STD-002E-2017           | 仅限浸焊和回流焊   | 温度范围 25℃-350℃                      |  |
|  |  | 19 | 邦线拉力  | 半导体分立器件试验方法 第 2 部分<br>MIL-STD-750-2A-2018<br>方法 2037.1 | 全部条件       | 拉力 $\leq$ 100g                     |  |
|  |  | 20 | 邦线剪切  | 引线邦定剪切试验<br>AEC-Q101-003A-2005                         | 全尺寸        | 剪切力 $\leq$ 100kg                   |  |
|  |  | 21 | 晶片剪切  | 半导体分立器件试验方法 第 2 部分<br>MIL-STD-750-2A-2018<br>方法 2017.3 | 全尺寸        | 剪切力 $\leq$ 100kg                   |  |